

На рис. 1–3 приведены результаты применения итерационной процедуры для уравнения теплопроводности (первая, восьмая и четырнадцатая итерации для функции V_1 на ячейке $2\pi \times 2\pi$), иллюстрирующие эффективность предлагаемой методики.

Литература

- Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. Осреднение процессов в периодических средах. М.: Наука, 1984.

- Медведев Г.Н., Моргунов Б.И. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1998. № 6. С. 47 (Moscow University Phys. Bull. 1998. No. 6).
- Моргунов Б.И. Математический анализ физико-механических процессов. М.: Изд-во МГИЭМ, 1995.

Поступила в редакцию
31.03.99

РАДИОФИЗИКА

УДК 621.391.81

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОГОНКИ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЛЯ В НЕОДНОРОДНОЙ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ИОНОСФЕРЕ

В. Д. Гусев, Е. Г. Михайлова, Л. И. Приходько

(кафедра физики атмосферы)

Предложены алгоритмы расчета комплексных коэффициентов отражения и нахождения структуры поля в неоднородной среде с высотным профилем эффективной частоты электронных соударений. Используемый метод прогонки позволяет рассматривать случаи как частичного, так и почти полного отражения волн от слоя и найти частотную зависимость коэффициента отражения.

При радиозондировании ионосферы и определении характеристик отраженного радиосигнала необходимо учитывать поглощение волн в ионосфере, которое существенно влияет на интенсивность принимаемых сигналов. Затухание радиоволн в ионосферной плазме связано с потерями, обусловленными соударениями электронов с нейтральными частицами. Эти потери приводят к отличной от нуля проводимости, а диэлектрическая проницаемость плазмы становится комплексной величиной. В реальных условиях ионосферного распространения эффективная частота электронных соударений ν_{eff} зависит от высоты. Об этом свидетельствуют как экспериментальные данные [1, 2], так и расчеты сечений соударений электронов с различными компонентами ионосферы. Полная частота электронных соударений в многокомпонентной плазме равна сумме эффективных частот соударений с различными компонентами (N_2 , O_2 , He, O, H): $\nu_{\text{eff}} = \sum_m \nu_m$. На рис. 1 приведены кривые зависимости ν_{eff} от высоты, построенные на основе табличных данных [3] для моделей дневной и ночной ионосферы. Область высот относится к ионосферному слою E .

Учет высотной зависимости $\nu_{\text{eff}}(z)$ при нахождении комплексных коэффициентов отражения существенно усложняет решение краевой задачи, описываемой для монохроматических волн уравнением Гельмгольца. Так, для общепринятой модели изотропной плоскостной ионосферы комплексная диэлектрическая проницаемость принимает вид

$$\epsilon_k(z) = \epsilon(z) + i(1 - \epsilon(z))\nu_{\text{eff}}(z)/\omega, \quad (1)$$

где ω — частота радиоволн.

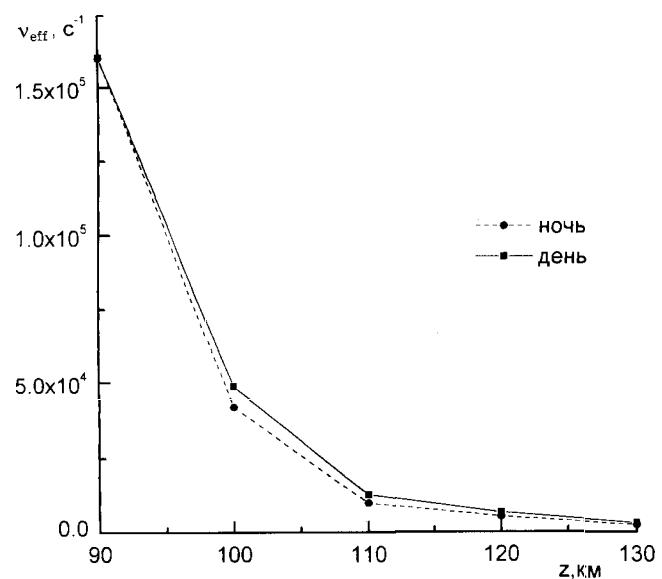


Рис. 1

Для учета дифракционных эффектов и тонких волновых явлений необходимо точное решение уравнения Гельмгольца для функции (1). Однако даже для простейших модельных ионосферных слоев получить аналитическое решение задачи не представляется возможным. Это обуславливает необходимость применения и развития численных методов расчета комплексных коэффициентов отражения и прохождения радиоволн для неоднородных ионосферных слоев. Так, в работах [4–6] разработаны численные алгоритмы, позволяющие рассчитывать отражение и прохождение радиоволн в ионосферных слоях произ-

вольной формы, в том числе в немонотонных слоях, когда при зондировании на частотах, близких к критическим, проявляется надбарьерное отражение или туннельное прохождение.

В настоящей работе предложены алгоритмы вычисления комплексных коэффициентов отражения и нахождения структуры поля в неоднородной среде с высотным профилем эффективной частоты электронных соударений. Используемый метод прогонки позволяет рассматривать случаи как частичного, так и почти полного отражения волн от слоя и найти частотную зависимость коэффициента отражения.

При радиозондировании ионосферы на частотах f в окрестности критической частоты слоя f_c профиль диэлектрической проницаемости слоя хорошо аппроксимируется параболой, т. е. при $0 \leq z \leq 2z_T$ выражение (1) принимает вид

$$\varepsilon_k(z) = 1 - \frac{f_c^2}{f^2} \left(1 - \frac{(z - z_T)^2}{z_T^2} \right) - i \frac{f_c^2}{f^2} \left(1 - \frac{(z - z_T)^2}{z_T^2} \right) \frac{\nu_{\text{eff}}(z)}{\omega}, \quad (2)$$

где z_T — полутолщина слоя, $f_c = \omega_c/2\pi = \sqrt{e^2 N_{\max}/(\pi m)}$ — критическая частота, $N_{\max} = N(z_T)$ — электронная концентрация в максимуме слоя, e, m — заряд и масса электрона.

Для изотропной плоскослоистой ионосферы и скалярных монохроматических волн комплексная амплитуда поля E радиоволны при вертикальном зондировании удовлетворяет уравнению Гельмгольца

$$\frac{d^2 E}{dz^2} + k^2 \varepsilon_k(z, \omega) E = 0. \quad (3)$$

Для расчета комплексного коэффициента отражения и структуры поля в слое (2) разделим пространство на три области: свободное пространство между нижней границей ионосферы и Землей; ионосферный слой, характеризующийся профилями $\varepsilon(z, f)$ и $\nu_{\text{eff}}(z)$ ($0 < z < 2z_T$), и свободное пространство за верхней границей ионосферы ($z > 2z_T$).

Пусть на неоднородный слой падает нормально из области $z < 0$ плоская волна единичной амплитуды. Тогда, используя граничные условия непрерывности поля E и его производной, найдем связь между полем и его производной на каждой из границ:

$$\frac{dE(0)}{dz} = -ik(2 - E(0)), \quad \frac{dE(L)}{dz} = -ikE(L), \quad (4)$$

где $L = 2z_T$. Комплексные коэффициенты отражения R и прохождения T выражаются через поле E на нижней и верхней границах:

$$R = E(0) - 1, \quad T = E(L) \exp(ikL). \quad (5)$$

Решение уравнения (3) с граничными условиями (4) проводилось численно методом прогонки. Используемый метод позволяет найти распределение поля E в неоднородном слое, а из значений поля

на границе по формулам (5) определить комплексные коэффициенты отражения и прохождения.

Поскольку шаг в численном расчете необходимо выбирать так, чтобы он был значительно меньше длины волны зондирующего излучения (в данном случае $10 \text{ м} < \lambda < 100 \text{ м}$), нами использовались различные значения количества интервалов n разбиения слоя: такие, чтобы каждый раз получался единичный шаг $h = 1 \text{ м}$. Для проверки устойчивости полученных решений проводилось увеличение шага h от 2 до 10 м. Слабые погрешности наблюдаются при $h = 3 \text{ м}$ и становятся значительными при $h = 10 \text{ м}$. Время расчета структуры поля в слое и коэффициентов отражения и прохождения на одной частоте зависит от толщины слоя и шага в численном расчете и составляет от 3 до 5 мин.

Отметим, что используемый метод прогонки при решении краевой задачи обеспечивает эффективность и устойчивость численных решений в случае зондирования как на критической частоте f_c , так и на частотах меньше и больше критической, т. е. позволяет проводить расчеты как при частичном, так и при почти полном отражении от ионосферных слоев.

На рис. 2 представлены результаты численного расчета структуры поля (модуля $|E|$, нормированного на единичную амплитуду падающей волны) в параболическом слое (2) с параболическим профилем $\nu_{\text{eff}}(z)$ при разных частотах радиозондирования. Полутолщина ионосферного слоя E составляет $z_T = 12 \text{ км}$. Критическая частота равна $f_c = 3,3 \text{ МГц}$.

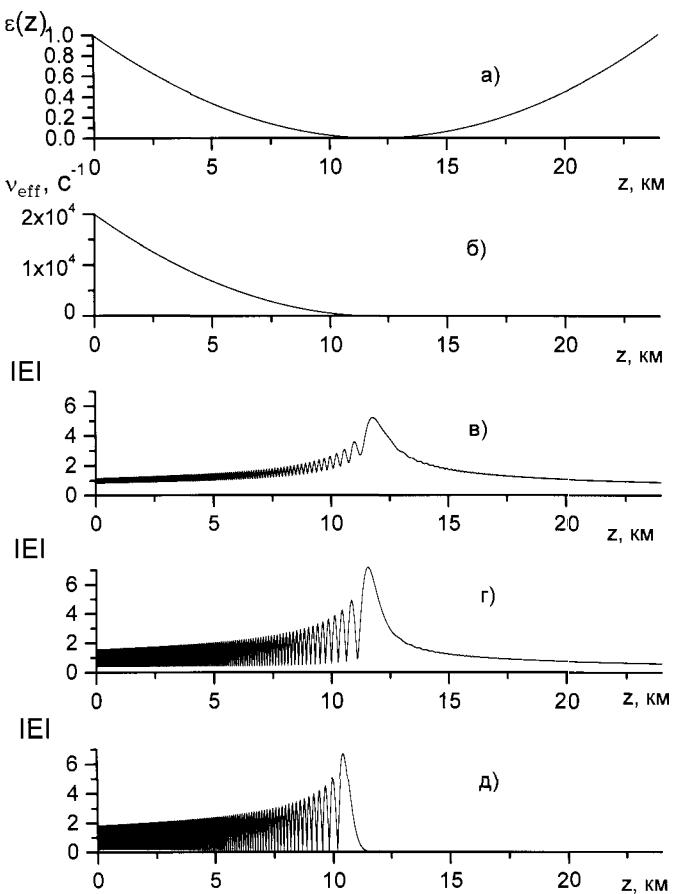


Рис. 2

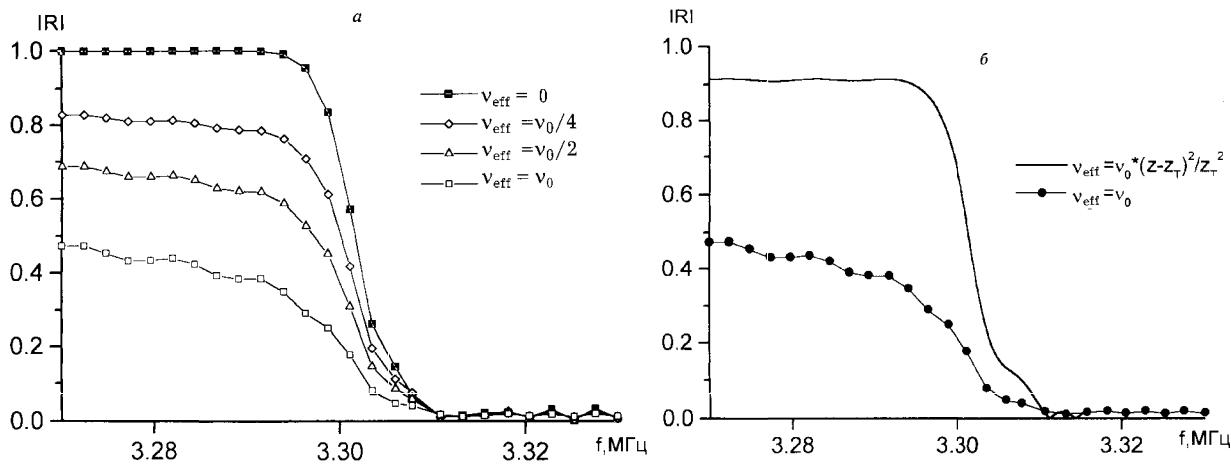


Рис. 3

Кривая α соответствует частоте $f > f_c$, кривая β — частоте f_c , кривая δ — частоте $f < f_c$. В случае $f > f_c$ ($f - f_c = 2$ кГц) коэффициент отражения весьма мал: $|R| = 0,16$ и имеет место достаточно большое просачивание волны через слой. При $f = f_c$ коэффициент отражения увеличивается, а осцилляции в области $0 < z < z_T$ становятся более глубокими. В случае $f < f_c$ ($f_c - f = 20$ кГц) структура поля меняется: в области $0 < z < z_T$ имеет место стоячая волна и коэффициент отражения сильно возрастает: $|R| = 0,81$, а при $z > z_T$ поле практически отсутствует.

На рис. 3, α приведены частотные зависимости модуля коэффициента отражения от ионосферного параболического слоя с теми же параметрами, что и на рис. 2, α , но с разной частотой электронных соударений v_{eff} . Характер спадания частотной зависимости $|R|$ в окрестности f_c и слабые осцилляции при $f > f_c$ соответствуют особенностям этих кривых, отмеченным в работе [3], где приведена зависимость $|R|$ от частоты в толстом слое без поглощения. Поглощение в слое существенно уменьшает коэффициент отражения и сглаживает кривые частотной зависимости.

На рис. 3, β приводятся частотные зависимости модуля коэффициента отражения от параболического слоя с параболическим профилем $v_{\text{eff}}(z)$ (верхняя кривая) и постоянным $v_{\text{eff}} = v_0$ (нижняя). Значительное уменьшение коэффициента отражения при $v_{\text{eff}} = v_0$ свидетельствует о существенном влиянии области отражения на поглощение волн в неоднородном слое.

Таким образом, в работе предложен численный

алгоритм решения краевой задачи для неоднородных поглощающих сред, позволяющий учитывать дифракционные эффекты и тонкие волновые явления. Показано, что использование этого метода в задачах радиозондирования ионосферы позволяет находить комплексные коэффициенты отражения и структуру поля при учете высотных зависимостей $\epsilon(z)$ и $v_{\text{eff}}(z)$. Предложенный алгоритм расчета дает возможность рассматривать отражение от слоев с произвольными профилями $\epsilon(z)$ и $v_{\text{eff}}(z)$ (в том числе немонотонными), поскольку не требует знания фундаментальной системы решений уравнения (3). Решение таких задач важно при интерпретации экспериментальных данных в реальных условиях ионосферного распространения. Полученные частотные зависимости коэффициента отражения могут быть использованы при решении обратных задач восстановления профилей $v_{\text{eff}}(z)$ в неоднородных ионосферных слоях.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 98-02-16834).

Литература

1. Дэвис К. Радиоволны в ионосфере. М.: Мир, 1973.
2. Альперт Я.Л. Распространение радиоволн и ионосфера. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
3. Гуревич А.В., Шварцбург А.Б. Нелинейная теория распространения радиоволн в ионосфере. М.: Наука, 1973.
4. Куницын В.Е., Смородинов В.А., Усачев А.Б. // Радиотехн. и электроника. 1989. 34, № 2. С. 233.
5. Журавлев С.В., Куницын В.Е., Усачев А.Б. // Радиотехника. 1992. № 12. С. 49.
6. Куницын В.Е., Усачев А.Б. // Радиотехника. 1991. № 1. С. 8.

Поступила в редакцию
26.06.98